Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)

INJECTION AND COOLING OF THE LOW ENERGY HEAVY ION BEAM IN THE RING

T.Shirai^{1,A)}, A.Noda^{A)}, M.Ikegami^{A)}, M.Tanabe^{A)}, H.Tongu^{A)}, H. Fadil^{A)}, S.Fujimoto^{A)}, T.Takeuchi^{B)}, K.Noda^{B)}, S.Shibuya^{B)}, T.Fujimoto^{B)}, H.Fujiwara^{B)}, H..Okamoto^{C)}, Y.Yuri^{C)}, M.Grieser^{D)}, E.Syresin^{E)}

^{A)}Advanced Research Center for Beam Science, ICR, Kyoto University, Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan ^{B)}NIRS, Inage-ku, Chiba, 263-8555, Japan

^{C)}ADSM, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima-City, 739-8530, Hiroshima, Japan

^{D)}MPI für Kernphysik, Heidelberg 69029, Germany

^{E)}JINR, 141980, Dubna, Moscow Region, Russia

Abstract

S-LSR is a new ion cooler ring, which is under construction in Kyoto University. It has an electron beam cooler for 7 MeV proton beam from a linac and 2 MeV/u Carbon beam from a laser ion source. Not only such MeV beam, but also low energy heavy ion beams can be stored in S-LSR from an ion source. The main subject of the heavy ions is a laser cooling to obtain the ultra low temperature beams and to study the phase transition to the crystalline beams. The injection and the extraction system of S-LSR are designed not only for 7 MeV proton beam, but also for the low energy heavy ion beams. The target vacuum pressure of S-LSR is less than 5×10^{-9} Pa to keep the enough life time for the heavy ion beams.

低エネルギー重イオンのS-LSRリングへの入射・蓄積とビーム冷却

1. はじめに

京都大学化学研究所では、小型イオンビーム蓄 積・冷却リング S-LSR の建設をおこなっている [1]。S-LSRは、周長が22.557m、最大磁気剛性が1 Tmで、6回対称形をしたリングである(図1参 照)。このリングは、電子ビーム冷却装置とレー ザー冷却装置をもち、「ビーム冷却技術」を中心に、 高密度イオンビームに関係する物理、ビーム冷却の 技術開発、冷却ビームの応用を研究目的としている。

このリングはその研究目的に合わせ、3種類の入 射器をもっている。1つは既存の7 MeV陽子線形加 速器を入射器として使用し、電子ビーム冷却を用い

た短バンチ生成などの実験を計画している。もうひ とつは超短パルス高強度レーザーによって加速され たMeV級のイオンを蓄積・電子ビーム冷却する実験 である。レーザーは隣接したレーザー棟から入射し、 発生した高エネルギーイオンを輸送・入射するため のトランスポートを準備している[2]。これらに対 し、より低温までの冷却を目指し、重イオンのレー ザー冷却(ドップラー冷却)をおこなう実験も計画 されている。

このレーザー冷却のために、S-LSRではイオン源 からでてくる50keV程度の低エネルギーイオン



¹ E-mail: shirai@kyticr.kuicr.kyoto-u.ac.jp

ビームを直接リングに入射する。これにより、磁気 剛性の小さなリングでも、価数の低い重イオンを蓄 積することができる。また、入射用の線形加速器を 必要としないため、イオン源の交換により、実験に 応じてさまざまな原子・分子イオンをリングへ入射 できるというメリットがある。ただし、反面、この ような低エネルギービームを蓄積するためには、特 別な入射・出射の方法を用意する必要があり、また 実用的なビーム寿命を得るために、詳細な真空シス テムの設計が必要となる。

2. 重イオンビームの入出射

レーザー冷却の実験においては、原子・分子の光 の吸収波長と、利用可能なレーザーの波長幅の関係 から、冷却できるイオン種は非常に限られている。 具体的には、Li⁺, Be⁺, Mg⁺ などである。S-LSRでは この中でもMg⁺の冷却を考えている。そのため、 CHORDIS型スパッターイオン源で、Mg⁺を生成す る。この入射ビームの仕様は、表1のとおりである。 S-LSRでは7MeVの陽子イオンビームの入射時は、 2台1セットのバンプ電磁石をもちいて、静電セプ タム部分にバンプ軌道をつくり、マルチターン入射 と1ターンの早い取り出しをおこなう。しかし、重 イオン源からの低エネルギーイオンビームの場合に は、レーザー冷却をおこなうために、そのレーザー スポット径の制限から、入射ビームサイズは1 cm 以下、エミッタンスにして5π.mm.mrad以下でなけ ればならない。そのためには、エミッタンスの小さ なビームのシングルターン入射が不可欠となる。

S-LSRの静電セプタムは、1つの真空チェンバー で、この両方の入射方式とシングルターンの取り出 しに対応できる構造となっている。図2はその静電 セプタムの図を示している。重イオンビームは中央 の静電キッカーにより曲げられて、直接リングの中 心軌道へと入射される。この電極への印加電圧は最 大±10kVであり、200nsecのスイッチング時間 をもつ高速高圧半導体スイッチによってON/OFFを おこない、入射を制御している。

これに対し、レーザビーム冷却によって冷やされ たビームの取り出しは、取り出し静電セプタムから、 位相が90度離れた位置に設置された、取出し静電 キッカーと静電セプタムによっておこなう。この静 電キッカーも電圧を高速にON/OFFして取り出しを 制御するが、入射用のキッカーに比べて、蹴り角が 小さいため、電圧は1kV程度で済む。

3. 重イオンビームの寿命

低エネルギー重イオンビームをもちいた実験において重要なことは、ビーム寿命 τ である。これは残留ガス密度 ρ 、反応断面積 σ 、イオンの速度 v_{ion} をもちいて、

$$\tau = \frac{1}{\sigma \rho v_{ion}} \tag{1}$$

であたえられる。この反応の中では、電子捕獲が

表 1	IJ	~	ガ	レ重ノ	ィオ	- `/	入射	~~	- 7	ரை	ペラ	×	-4
11 1	~	~	1	く里く	1 4	~	<u></u>	L-	4	0)/	· /	\sim	- 7

リング	
周長	22.557 m
平均半径	3.59 m
ドリフトスペース長	1.86 m
周期数	6
入射イオンビーム	
入射イオンビーム イオン種	Mg ⁺
入射イオンビーム イオン種 全エネルギー	Mg ⁺ 30 – 50 keV
入射イオンビーム イオン種 全エネルギー 蓄積イオン数	Mg^+ 30 - 50 keV 10 ⁴ - 10 ⁷



図2 入射・取り出しのための静電セプタム。 中央の10kV静電キッカーで重イオン ビームの入射をおこなう。



図3 50keV、Mgビームの残留ガスとの多重 散乱によるエミッタンス増加

もっとも断面積が大きい。一般にこの電子捕獲断面 積は、ビームのエネルギーが低くなると急激に大き くなって(∝E⁸)、寿命が短くなることが知られて いるが、1価程度のイオンでは、核子あたりのエネ ルギーが10keVの領域で最大値をとり、それより 低エネルギー側では減少する。これに加えて、式 (1)により、イオンの速度v_{ion}に反比例しても延びる ことになる。

S-LSRの設計平均真空度は5x10⁹ Paであるので、 50keV Mg⁺の計算寿命は36秒になる[2]。これか ら、1価のイオンであれば、50keVでも実験に必 要なビーム寿命が得られることがわかる。

図3は、このときの多重散乱によるエミッタン ス増加を計算したシミュレーション結果である。 これから、多重散乱による寿命は、電子捕獲の寿 命よりも長いことがわかるが、レーザーによる冷 却力を切ると、数秒でエミッタンスが増加するこ ともわかる。

4. ビーム冷却シミュレーション

レーザー冷却実験の最大の目的は、極低温ビームの実現と、それによって予想されるビーム結晶 化の相転移のメカニズムを実験によって示すこと である。極低温まで冷やすためには、冷却力が強い だけでなく、リングの共鳴現象に起因するエンベ ロープ不安定性を回避しなければならない[3]。そ のため、S-LSRでは、表2に挙げているように動作 点をとれるように設計している。チューンが(1.45, 1.44)の場合は、1ピリオドあたりのベータトロン位 相の進みが90度以下になり、エンベロープ不安定 性を回避できる動作点である。図3には、このとき の1ピリオド内でのツイスパラメータの分布を示し ている。

チューンが(2.08, 1.07)の場合は、ベータトロン位相 の進みが90度を超えるが、メンテナンス条件と呼 ばれる127度は下回っており、粒子数が少なけれ ば、結晶化が起きる可能性がある[4]。この動作点 では、シンクロトロンチューンを0.07にすることに より、縦・横の3次元的結合がおき、3次元のレー ザー冷却が可能となる[5]。

表4は、分子動力学計算コードSOLID[6]をもちいて、S-LSRで生成するビーム結晶の構造と蓄積粒子数の相関である。結晶の形は、磁場による収束力の影響を受けるので、チューンに依存するが、相転移点の粒子数は一定である。

5. まとめ

S-LSRではイオン源から重イオンビームを直接入 射できるようにすることにより、レーザー冷却をは じめとするさまざまな実験を計画している。本発表 でも述べたように、低エネルギーイオンビームをも ちいた実験を可能にするために、ビーム冷却・入 射・取り出し・寿命の観点から、検討・設計を進め ている。リング自身は今秋からアライメントを開始 し、来春のコミッショニングを目指している。

6. 謝辞

本研究を進めるにあたっては、京都大学化学研究 所の風間氏に、多大な協力をいただきました。ここ に感謝いたします。また、本研究は先進小型加速器 事業の一環としておこなわれました。

表 3	レーザー冷却時の動作点	と.	パラ	メ	ータ
-----	-------------	----	----	---	----

Betatron tune	(1.45, 1.44)	(2.08, 1.07)
Phase advance /period	(86.9, 86.3 deg)	(125, 64.2 deg)
Field gradient of QM	-1.58 m ⁻²	1.42 m^{-2}
Chromaticity	(-0.10, 1.26)	(-1.21 -0.18)
Max. β-function	(4.33, 2.74 m)	(4.20, 5.32 m)
Max. hori. dispersion	2.42 m	1.32 m
Transition γ	1.23	1.76
Moment. Compaction	0.658	0.321



図3 表3の中でチューンが (1.45, 1.44)の 時の、1 ピリオドのツイスパラメータ

表4 表3の2つの動作点での、結晶構造と 蓄積粒子数の関係

Particle	Crystal Structure	Crystal Structure			
number	(Qx=1.45)	(Qx=2.08)			
1.8 x 10 ⁵	String	String			
4.0 x 10 ⁵	Horizontal Zigzag	Vertical Zigzag			
5.3 x 10 ⁵	Horizontal 3-line	Vertical 3-line			
7.8 x 10 ⁵	Horizontal 4-line	Single Shell (3D)			
1.6 x 10 ⁶	Single Shell (3D)	Single Shell (3D)			

参考文献

- A. Noda et al., Proc. of Symposium on Accel. Sci. and Tech. (2001) 125.
- [2] H. Tonguu et al., in this proceedings
- [3] L. Tecchio, Nucl. Instr, and Meth, in Phys. Res. A 391 (1997) 147.
- [4] J. Wei, X.-P. Li, A. M. Sessler, Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 3089.
- [5] T. Kihara et al., Phys. Rev. E, 59, 3594-3604 (1999)
- [6] J. Wei, X-P Li, A. M. Sessler, Reprt BNL-52381 (1993).